

# Конверсия оптического излучения в терагерцевое на поверхности полуметалла

В.А.Миронов, И.В.Оладышкин, Д.А.Фадеев

*Рассмотрена возможность генерации широкополосного терагерцевого (ТГц) излучения при отражении р-поляризованного фемтосекундного лазерного импульса от поверхности полуметалла. Проведено обобщение гидродинамической модели мгновенного квадратичного отклика металлов, представлены аналитические результаты и данные численного моделирования. Показано, что при переходе от хорошо проводящих металлов к полуметаллам следует ожидать значительного увеличения эффективности генерации ТГц сигнала вследствие уменьшения эффективной массы носителя заряда и ослабления экранировки оптического и ТГц полей.*

**Ключевые слова:** полуметалл, терагерцевое излучение, фемтосекундные лазерные импульсы, нелинейная оптика.

## 1. Введение

Активное освоение терагерцевого (ТГц) диапазона электромагнитных волн привело к заметному развитию физики нелинейного преобразования оптического излучения в низкочастотное. В частности, в настоящее время большое внимание уделяется экспериментальному и теоретическому исследованию генерации ТГц излучения при взаимодействии фемтосекундных лазерных импульсов с поверхностями металлов и других проводящих сред [1–9]. Детальное изучение генерации ТГц излучения при его отражении от границы среды имеет целью не только оптимизацию эффективности преобразования оптического излучения в терагерцевое, но и исследование в совокупности с другими электродинамическими методами (генерацией поверхностных волн, гармоник оптического поля и др. [10, 11]) самого материала [12].

Особенности генерации ТГц излучения при отражении фемтосекундных импульсов от поверхностей хорошо проводящих металлов (золото, медь, алюминий и др.) достаточно подробно исследованы [1–9, 12]; эффективность генерации при типичных экспериментальных параметрах оказывается низкой, порядка  $10^{-7}$  (по энергии). В теоретических работах [7, 8] показано, что малая эффективность преобразования лазерных импульсов связана с большой концентрацией свободных носителей заряда: объемные токи в плотной плазме почти полностью экранируют излучение нелинейного поверхностного тока.

Цель настоящей работы – обратить внимание на новый для данной области класс материалов – полуметаллы. Далее будет представлено обобщение гидродинамической модели генерации ТГц излучения, развитой в работах [5, 7, 8], на случай полуметаллов, которые имеют сравнительно небольшую концентрацию электронов в зоне

проводимости. Для получения мгновенного квадратичного отклика такой среды оказывается принципиально важным учет межзонных переходов и существенной анизотропии эффективных масс носителей заряда.

В работе изложены аналитические результаты, а также представлены данные численного моделирования в рамках полной гидродинамической модели. Приведены сравнительные оценки для обычных металлов и висмута, линейные электродинамические характеристики которого подробно экспериментально исследованы в широком диапазоне частот [13–15]. Показано, что при переходе от металлов к полуметаллам следует ожидать заметного увеличения эффективности генерации ТГц излучения за счет мгновенного квадратичного отклика электронов. Кроме того, в соответствии с развитой моделью ТГц отклик висмута должен быть чувствительным к ориентации монокристаллического образца из-за сильной анизотропии тензора эффективных масс электрона. Тем самым конверсия оптического излучения в ТГц излучение на поверхностях полуметаллов может представлять интерес с точки зрения исследования их электродинамических характеристик.

В разд.2 описаны характеристики падающего и отраженного лазерного излучения в рамках линейной модели. Представленные там общие выражения используются в разд.3 при выводе соотношения для продольного поверхностного тока, который наводится лазерным импульсом на поверхности образца. В разд.4 рассмотрена задача излучения электромагнитного импульса поверхностным источником тока, движущимся вдоль поверхности с фазовой скоростью, превышающей скорость света в вакууме. В разд.5 представлены заключительные замечания. В Приложении даны уточняющие сведения по использованным численным методам со ссылками на предыдущую работу авторов.

## 2. Отражение лазерного импульса от поверхности полуметалла

Рассмотрим образец из полуметалла, на поверхность которого падает монохроматическое р-поляризованное

В.А.Миронов, И.В.Оладышкин, Д.А.Фадеев. Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики РАН, Россия, 603950 Н.Новгород, ул. Ульянова, 46; e-mail: oladyshkin@gmail.com

Поступила в редакцию 30 марта 2016 г., после доработки – 21 июня 2016 г.

оптическое излучение. Введем систему координат, направив ось  $z$  вдоль поверхности в плоскости падения, ось  $x$  – перпендикулярно поверхности, ось  $y$  – перпендикулярно плоскости падения. Поскольку действительная часть диэлектрической проницаемости  $\varepsilon$  на оптических частотах велика по модулю и отрицательна [15], электрическое поле  $E$  экспоненциально спадает в глубину образца:

$$E_x = E_{x0} \exp(k_0 \sqrt{-\varepsilon} x - ik_0 z \cos \alpha), \quad (1)$$

$$E_z = E_{z0} \exp(k_0 \sqrt{-\varepsilon} x - ik_0 z \cos \alpha), \quad (2)$$

где угол падения  $\alpha$  отсчитывается от оси  $z$ ;  $k_0 = \omega_0/c$  – волновое число оптического излучения в вакууме;  $E_{x0}$  и  $E_{z0}$  – амплитуды волн на границе образца. Коэффициент отражения  $R$  можно представить в следующем виде [16]:

$$R = \frac{\varepsilon \sin \alpha - \sqrt{\varepsilon}}{\varepsilon \sin \alpha + \sqrt{\varepsilon}}. \quad (3)$$

Интерференция падающей и отраженной волн приводит к тому, что вблизи границы раздела двух сред ( $x = 0$ ) суммарное поле распространяется вдоль поверхности с фазовой скоростью, превышающей скорость света (см. подробнее в [7]). Таким образом, если лазерный импульс имеет достаточно малую длину по сравнению со своим поперечным размером, то в области перекрытия падающего и отраженного оптического излучения формируется сверхсветовое освещенное пятно («зайчик»). Как будет показано ниже, в этом пятне на поверхности полуметалла возможно возбуждение низкочастотного нелинейного тока. Для его нахождения необходимо конкретизировать электродинамическую модель среды.

Диэлектрическая проницаемость висмута довольно хорошо экспериментально изучена и теоретически интерпретирована [13, 14]. Она определяется поляризационным откликом кристаллической решетки, а также межзонными переходами и внутризонным движением электронов. В дальнейшем мы будем использовать феноменологическую модель линейного отклика, содержащую лишь небольшое число параметров. При их определении мы будем ориентироваться на экспериментально наблюдаемую зависимость диэлектрической проницаемости висмута от частоты в исследуемой области [15]. Внутризонное движение дырок не будет учитываться при получении поляризационного отклика, поскольку их эффективная масса много больше массы электронов.

Поляризационный отклик висмута имеет характерное резонансное поведение вблизи частоты  $\omega_b \sim 10^{15} \text{ с}^{-1}$ , обусловленное переходами электронов из заполненной валентной зоны или из зоны проводимости в лежащую выше пустую зону (характерная разность энергий составляет 1–0.7 эВ). Учтем этот вклад, воспользовавшись моделью гармонического осциллятора для описания динамики поляризации среды:

$$\ddot{P} + \nu_b \dot{P} + \omega_b^2 P = \beta E(t), \quad (4)$$

где  $\omega_b$  – собственная частота осциллятора;  $P$  – поляризация среды;  $\nu_b$  – эффективная частота потерь;  $\beta$  – коэффициент связи;  $E(t)$  – электрическое поле; точка над буквой означает дифференцирование по времени.

Движение частиц внутри зоны проводимости можно описать на основе модели свободных электронов:

$$\ddot{r}_f = -\nu_f \dot{r}_f - e \hat{M}_f^{-1} E, \quad (5)$$

где  $r_f$  – классическая координата электрона;  $e$  – заряд электрона;  $\hat{M}_f$  – тензор эффективных масс свободного электрона;  $\nu_f$  – эффективная частота столкновений. Поляризационный отклик, связанный с внутризонным движением электронов, будет важен в дальнейшем при получении нелинейного тока. Ниже мы будем рассматривать оптическое поле, поляризованное в плоскости  $xz$ , предполагая, что соответствующая подматрица  $\hat{M}_f$  диагональна и имеет диагональные компоненты  $m_x$  и  $m_z$ . В случае висмута модель (4) приводит к следующей аппроксимации для диэлектрической проницаемости, которая может быть использована в оптическом диапазоне частот:

$$\varepsilon(\omega) = \frac{\beta}{\omega_b^2 - \omega(\omega - i\nu_b)}. \quad (6)$$

Формула (6) с достаточной точностью воспроизводит экспериментально наблюдаемую комплексную диэлектрическую проницаемость висмута [15] при  $\omega_b = 1 \times 10^{15} \text{ с}^{-1}$ ,  $\sqrt{\beta} = 9 \times 10^{15} \text{ с}^{-1}$ ,  $\nu_b = 1 \times 10^{15} \text{ с}^{-1}$ .

В первом приближении монохроматическое поле (1), (2) вызывает осцилляции свободных и «связанных» электронов на частоте  $\omega_0$ . Поскольку движение приповерхностных носителей в перпендикулярном к границе направлении оказывается нелинейным, это приводит к формированию низкочастотного поверхностного тока.

### 3. Нелинейный ток

Поперечная компонента электрического поля  $E_x$  индуцирует некоторый заряд вблизи поверхности полуметалла. Электроны, локализованные вблизи границы, смещаются продольным электрическим полем лазерного излучения и создают нелинейный поверхностный ток. Для количественного описания этого процесса рассмотрим уравнения гидродинамики в представлении комплексных амплитуд. Изменение концентрации электронов  $n$  под действием лазерного поля найдем из уравнения непрерывности

$$i\omega_0 e \delta n = \text{div } j, \quad (7)$$

где  $j = -i\omega_0 e n_0 r_f$ ;  $n_0$  – невозмущенная концентрация электронов проводимости. Отметим, что поперечная компонента тока  $j_x(x)$  имеет разрыв на границе висмут–вакуум, что отвечает наводимому на поверхности заряду. В то же время обе компоненты тока в скин-слое создают возмущение заряда. Таким образом, выражение для возмущения концентрации записывается в следующем виде:

$$\delta n = -\frac{en_0 \exp(-ik_z z)}{\omega_0^2 - i\nu_f \omega_0} \left\{ \frac{E_x|_{x=0}}{m_x} [-\delta(x) - ik_x \exp(-ik_x x)] - ik_z \exp(-ik_x x) \frac{E_z|_{x=0}}{m_z} \right\}, \quad (8)$$

где  $k_x = k_0 \sqrt{-\varepsilon}$ ;  $k_z = k_0 \cos \alpha$ . Продольный низкочастотный ток может быть получен путем усреднения произведения концентрации и продольной скорости электронов по оптическому периоду. Далее мы будем рассматривать только продольный нелинейный ток, т. к. именно он вносит основной вклад в излучение с поверхности висмута

при конфигурациях эффективных масс (т.е. ориентациях кристалла), соответствующих максимальной эффективности генерации ТГц излучения.

Подставляя значения электрических полей на поверхности висмута в выражение (8), после усреднения получаем окончательно следующее выражение для плотности продольного тока в скин-слое:

$$j_{z\text{ТГц}} = -\frac{e^3 |E_0|^2 n_0 \sin^2 \alpha |1 - R|^2 \exp(2x \operatorname{Im} k_x)}{2cm_z (\omega_0^2 + v_f^2)} \times \left\{ \frac{1}{m_x} \left[ \delta(x) \frac{\operatorname{Im} k_x}{k_0^2 |\varepsilon(\omega_0)|} - 1 \right] + \frac{1}{m_z} \right\}. \quad (9)$$

Интегрируя (9) по глубине скин-слоя, находим выражение для поверхностного тока:

$$J_{\text{surf}} = -\frac{e^3 |E_0|^2 n_0 \sin^2 \alpha \cos \alpha |1 - R|^2}{4cm_z (\omega_0^2 + v_f^2) \operatorname{Im} k_x} \times \left\{ \frac{1}{m_x} \left[ \frac{(\operatorname{Im} k_x)^2}{k_0^2 |\varepsilon(\omega_0)|} - 1 \right] + \frac{1}{m_z} \right\}. \quad (10)$$

В случае фемтосекундного лазерного импульса, длина которого много меньше его поперечного размера, нелинейный ток будет появляться в области перекрытия падающего и отраженного оптического излучения, распространяясь вдоль поверхности полуметалла. Временная форма тока (10) будет определяться огибающей лазерного импульса.

Поверхностный ток  $J_{\text{surf}}$ , «пробегающий» со сверхсветовой скоростью по границе раздела вакуума и полуметалла (среда с большим по модулю  $\varepsilon$ ) возбуждает внутри материала систему объемных низкочастотных токов. Будем считать, что ток создается наклонно падающим лазерным импульсом с достаточно большим поперечным размером, поэтому величина  $J_{\text{surf}}$  зависит только от бегущей координаты  $\xi = t - (z \cos \alpha)/c$ . Такая геометрия соответствует типичным экспериментальным условиям при генерации ТГц излучения на поверхности металла [2–4, 8]. Поскольку скорость движения данного источника больше скорости света, создаваемое им излучение имеет черенковский характер.

#### 4. Электромагнитное излучение поверхностного тока

Рассмотрим решение задачи об излучении найденного поверхностного тока. Для описания излучения запишем уравнения Максвелла с источником поверхностного тока  $S(t)$ :

$$\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = -c \operatorname{rot} \mathbf{E}, \quad (11)$$

$$\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = c \operatorname{rot} \mathbf{H} - 4\pi \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} - 4\pi \mathbf{j}, \quad (12)$$

$$\frac{\partial^2 \mathbf{P}}{\partial t^2} + v_b \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} + \omega_b^2 \mathbf{P} = \beta \mathbf{E}, \quad (13)$$

$$\frac{\partial \mathbf{j}}{\partial t} + v_f \mathbf{j} = e^2 \hat{M}_f^{-1} n_0 \mathbf{E} + S(t) \delta(x). \quad (14)$$

Переходя к задаче нахождения полей черенковского излучения, сделаем замену  $z \rightarrow z - Vt$  ( $c/\cos \alpha = V$ ) и будем искать стационарное решение ( $\partial/\partial t = 0$ ). С учетом значения диэлектрической проницаемости висмута, чтобы не загромождать выкладки, в уравнении (12) можно пренебречь левой частью. Тогда получим следующую систему уравнений для электромагнитных полей внутри висмута ( $-L < x < 0$ ):

$$\frac{V}{c} \frac{\partial H_y}{\partial z} = \frac{\partial E_z}{\partial x}, \quad (15)$$

$$\frac{\partial H_y}{\partial x} = 4\pi \frac{V}{c} \frac{\partial P_z}{\partial z} + \frac{4\pi}{c} j_z, \quad (16)$$

$$V^2 \frac{\partial^2 P_z}{\partial z^2} + v_b V \frac{\partial P_z}{\partial z} + \omega_b^2 P_z = \beta E_z, \quad (17)$$

$$V \frac{\partial j_z}{\partial z} + v_f j_z = \frac{e^2}{m_z} n_0 E_z. \quad (18)$$

В системе отсутствуют уравнения для поперечных компонент, т.к. при исключении слагаемого ( $\partial E_x/\partial z$ ) в уравнении (11) система замыкается. После расчета полей излучения мы вернемся к условиям применимости сделанного приближения.

На поверхности висмута (в окрестности  $x = 0$ ) для плотности тока будем иметь выражение

$$V \frac{\partial j_z}{\partial z} + v_f j_z = S(z/V) \delta(x). \quad (19)$$

Переходя в (15)–(18) к фурье-представлению вдоль координаты  $z$  и разрешая полученную систему относительно магнитного поля, получаем уравнение

$$\frac{\partial^2 H_y}{\partial x^2} = -\chi H_y, \quad (20)$$

$$\chi = \frac{1}{c^2} \left( \frac{4\pi\beta V^2 k_z^2}{-V^2 k_z^2 + v_b V i k_z + \omega_b^2} - \frac{4\pi e^2 n_0}{m_0} \frac{V i k_z}{v_b + V i k_z} \right), \quad (21)$$

где  $m_0$  – масса свободного электрона.

Граничные условия в случае слоя висмута, занимающего область  $-L < x < 0$ , выглядят следующим образом:

$$H_y|_{x=-0} - H_y|_{x=+0} = \frac{4\pi}{c} J_{\text{surf}}, \quad (22)$$

$$H_y|_{x=-L+0} - H_y|_{x=-L-0} = 0. \quad (23)$$

В вакууме для черенковского поля излучения можно записать выражения

$$H_y|_{x=+0} = -\frac{E_z|_{x=0}}{\sin \alpha}, \quad (24)$$

$$H_y|_{x=-L-0} = \frac{E_z|_{x=-L}}{\sin \alpha}. \quad (25)$$

Внутри висмута, в соответствии со сделанными приближениями, электрическое поле связано с магнитным следующим соотношением:

$$\frac{\partial H_y}{\partial x} = -\frac{c\chi}{Vik_z} E_z. \tag{26}$$

Используя граничные условия (22), (23) и связи между магнитным и электрическим полями на границах висмут–вакуум (24)–(26), с учетом непрерывности продольного электрического поля  $E_z$  можно получить линейную систему уравнений для коэффициентов общего решения для магнитного поля

$$H_y = A \exp(i\sqrt{\chi}x) + B \exp(-i\sqrt{\chi}x). \tag{27}$$

Решая эту систему уравнений, получаем следующие выражения для магнитного поля излучения над и под слоем висмута:

$$H_y|_{x=+0} = -\frac{1}{\sin\alpha} \frac{Vk_z}{c\sqrt{\chi}} (A - B), \tag{28}$$

$$H_y|_{x=-L-0} = \frac{1}{\sin\alpha} \frac{Vk_z}{c\sqrt{\chi}} [A \exp(i\sqrt{\chi}L) - B \exp(-i\sqrt{\chi}L)], \tag{29}$$

где

$$A = \frac{4\pi}{c} \frac{J_{\text{surf}}}{f_- - (f_+^2/f_-) \exp(2i\sqrt{\chi}L)};$$

$$B = \frac{4\pi}{c} \frac{J_{\text{surf}}}{f_+ - (f_-^2/f_+) \exp(-2i\sqrt{\chi}L)};$$

$$f_{\pm} = 1 \pm \frac{k_z V}{c\sqrt{\chi} \sin\alpha}.$$

Возвращаясь к условиям применимости использованного в уравнении (11) приближения, отметим, что из выражения для поперечной компоненты векторного уравнения (12) по аналогии с (26) следует соотношение

$$E_x \sim \frac{c}{V} \frac{k_z^2 H_y}{\chi}. \tag{30}$$

Откуда очевидно, что

$$\frac{\partial H_y}{\partial z} = \frac{V}{c} \frac{\partial E_z}{\partial x} \gg \frac{V}{c} \frac{\partial E_x}{\partial z}.$$

В случае полупространства, занятого висмутом, решение, представленное выше, соответствует с точностью до малых поправок общему решению из работ [7, 8]

$$E_z = \frac{4\pi}{c\sqrt{-\epsilon_{\text{THz}}}} j_{\text{surf}}, \tag{31}$$

где  $\epsilon_{\text{THz}}$  – диэлектрическая проницаемость в ТГц диапазоне частот. Магнитное поле над поверхностью металла (в вакууме) может быть найдено из уравнений Максвелла:

$$H_y = \frac{E_z}{\sin\alpha}. \tag{32}$$

Поток энергии низкочастотного излучения с единицы поверхности (т.е. нормальная компонента вектора Пойнтинга)

$$S_x = \frac{c}{4\pi} E_z H_y^* = \frac{4\pi}{c |\epsilon_{\text{THz}}| \sin\alpha} |j_{\text{surf}}|^2. \tag{33}$$

Для оценки предположим, что падающий оптический импульс имеет гауссову огибающую по радиальной координате и по времени, т.е. его интенсивность на поверхности образца пропорциональна

$$|E|^2 = E_0^2 \exp\left(-\frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{a_z^2} - \frac{\xi^2}{T^2}\right), \tag{34}$$

где  $a$  – поперечный размер лазерного пучка;  $T$  – длительность лазерного импульса, причем  $cT \ll a$ ;  $a_z = a/\sin\alpha$ . В соответствии с условием черенковского синхронизма низкочастотное излучение будет сосредоточено в направлении отражения лазерного пучка. Интегрируя по времени и по площади поверхности поток энергии (33), можно вычислить полную энергию, излученную в виде низкочастотного импульса при отражении оптического излучения от полуметалла:

$$W_{\text{Bi}} \simeq \frac{e^6 E_0^4 n_0^2}{c |\epsilon| \omega_0^6} a^2 T \left(\frac{0.77}{m_x m_z} + \frac{1}{m_z^2}\right)^2 \times \frac{\sin^2\alpha \cos^2\alpha}{(1 + 4 \sin\alpha + 29 \sin^2\alpha)^2}. \tag{35}$$

Как видно из формулы (35), энергия низкочастотного отклика должна сильно зависеть от ориентации монокристаллического образца (которая определяет величину эффективных масс  $m_z$  и  $m_x$ ).

Полученные выше аналитические результаты сравнивались с численным решением задачи Коши, описывающей падение и отражение лазерного импульса, формирование низкочастотных нелинейных токов и их излучение в виде ТГц импульсов. Моделирование проводилось до достижения стационарного состояния, соответствующего черенковскому режиму генерации и исключающего эффекты включения (подробности см. в Приложении). Результаты моделирования для угла падения  $\alpha = 33.5^\circ$  представлены на рис.1. При численном моделировании использовался достаточно тонкий слой висмута с толщиной  $\lambda_0/3$ , где  $\lambda_0$  – длина волны оптического импульса.

Наилучшее совпадение численного решения с аналитическим для излученного низкочастотного поля достигается при наибольшей поперечной эффективной массе электронов. В этом случае излучение может быть описано только продольными токами. В табл.1 представлена рассчитанная эффективность генерации для различных расположений осей кристалла по отношению к плоско-

Табл.1. Энергия ТГц излучения (в отн. ед.) для различных комбинаций эффективных масс электрона по осям  $x$  и  $z$ , полученная при численном моделировании в рамках полной системы уравнений гидродинамики электронного газа. Рассмотрена пластинка конечной толщины, ТГц сигналы с верхней и нижней поверхностями просуммированы.

$m_0/m_z$	$m_0/m_x$		
	3.84	200	1000
3.84	–	$1.15 \times 10^{-5}$	$2.15 \times 10^{-3}$
200	$3.3 \times 10^{-3}$	–	$3.12 \times 10^{-1}$
1000	1.88	2.25	–

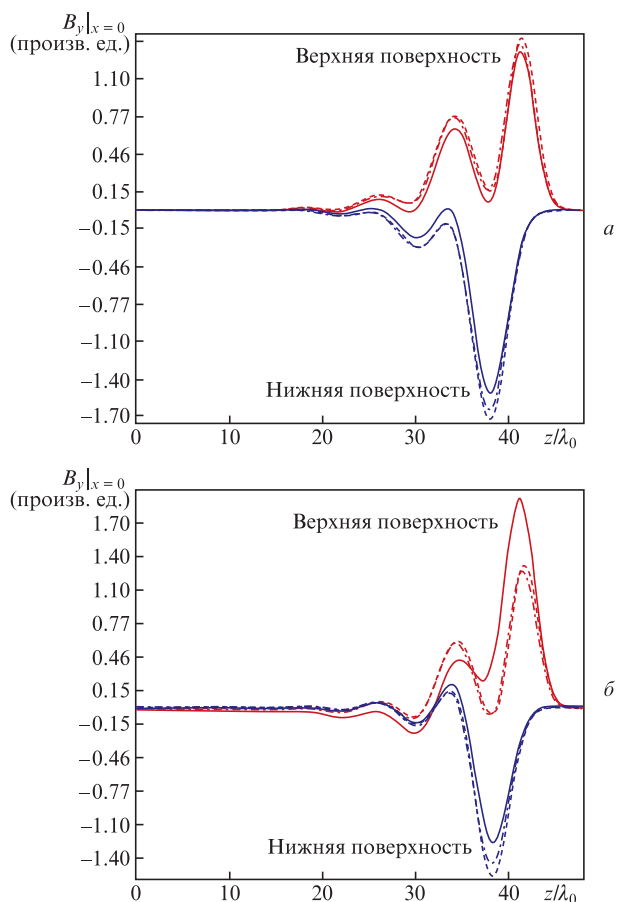


Рис.1. Форма излученного ТГц сигнала с верхней и нижней поверхностей пластинки висмута конечной толщины при  $m_0/m_x = 3.84, m_0/m_z = 1000$  (а) и  $m_0/m_x = 200, m_0/m_z = 1000$  (б). Сплошные кривые отображают результаты численного моделирования полной системы нелинейных гидродинамических уравнений, штриховые кривые соответствует аналитическому решению, штрих-пунктирные – численному моделированию с заданным тангенциальным источником тока (7).

сти падения. Видно, что наибольшая эффективность генерации достигается, когда наименьшая эффективная масса электронов соответствует направлению, определяемому пересечением плоскости падения с поверхностью образца.

Сравним энергию низкочастотного излучения (35) для висмута с энергией излучения с поверхности хорошо проводящего металла (золото, медь, алюминий и др.). При оптимальном угле падения лазерного импульса на металл полная энергия ТГц отклика, обусловленного мгновенной квадратичной нелинейностью, описывается следующим выражением [7]:

$$W_m = \frac{9}{32} \sqrt{\pi/2} \frac{e^2}{m_0^2} \frac{a^2}{\omega_0^2 \omega_m^2 c T} E_0^4, \quad (36)$$

где  $\omega_m$  – плазменная частота электронов в металле. Отношение энергий (35) и (36) для характерной плазменной частоты металла  $\omega_m \approx 20-30 \text{ фс}^{-1}$  при длительности лазерного импульса 50 фс

$$\frac{W_{Bi}}{W_m} \approx 10^4. \quad (37)$$

Таким образом, при переходе к полуметаллам следует ожидать значительного увеличения энергии генерируемого низкочастотного излучения из-за существенного умень-

шения эффективной массы электрона в кристалле. Кроме того, степень экранировки оптического и низкочастотного излучений внутри полуметалла (пропорциональная  $|\epsilon|^{-3} |\epsilon_{THz}|^{-1}$ ) может оказаться меньше, чем в нормальном металле (где она пропорциональна  $(\omega_m T)^{-2}$ ).

### 5. Заключение

В настоящей работе предложена теоретическая модель генерации ТГц излучения при воздействии на поверхность полуметалла фемтосекундного лазерного импульса. Рассмотренный механизм является обобщением механизма мгновенного квадратичного отклика металлов, проанализированного в работах [5, 7].

Показано, что при переходе от хорошо проводящих металлов к полуметаллам следует ожидать значительного увеличения амплитуды низкочастотного отклика (37) за счет снижения эффективной массы носителя заряда и ослабления экранировки электромагнитных полей. Кроме того, модель предсказывает сильную зависимость энергии ТГц сигнала от эффективных масс электрона по направлениям  $x$  и  $z$  (35), т. е. от ориентации монокристаллического образца.

Авторы выражают благодарность В.Я.Алёшкину, А.М.Сатанину и А.А.Балакину за полезные обсуждения содержания работы и помощь в подготовке рукописи.

Работа поддержана РФФИ (гранты № 16-32-00717, 16-02-01078 и 14-22-02034).

### Приложение. Численное моделирование

Для численного расчета задачи об излучении ТГц импульсов был модифицирован подход, разработанный ранее для металлов в работе [7]. В этом подходе рассчитывается задача Коши с источником, моделирующим падение оптического импульса с плоским волновым фронтом на поверхность. Расчет ведется до установления стационарной картины черенковского излучения. При численном моделировании учитываются как гидродинамические нелинейности, появляющиеся из слагаемого  $(\mathbf{v}\nabla)\mathbf{v}$ , так и нелинейности, связанные с действием магнитного поля и с неоднородностью концентрации свободных носителей, возникающей под действием лазерного поля. При этом учитывается также наличие у электронного газа температуры  $T_{0\text{eff}}$ , соответствующей энергии Ферми в висмуте. Для учета влияния связанных электронов в модель [7] было добавлено уравнение, описывающее поляризацию:

$$\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = -c \text{rot} \mathbf{E},$$

$$\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = c \text{rot} \mathbf{H} - 4\pi \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} - 4\pi \mathbf{j},$$

$$\frac{\partial^2 \mathbf{P}}{\partial t^2} + \nu_b \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} + \omega_b^2 \mathbf{P} = \beta \mathbf{E},$$

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{1}{e} \text{div} \mathbf{j},$$

$$\frac{\partial \mathbf{j}}{\partial t} + \nu_i \mathbf{j} = \frac{1}{n} [(\mathbf{j}\nabla)\mathbf{j} - \mathbf{v} \text{div} \mathbf{j}] + e^2 \hat{M}_f^{-1} n \mathbf{E}$$

$$+ \frac{e}{c} \hat{M}_f^{-1} \mathbf{j} \times \mathbf{B} + T_{0\text{eff}} \nabla n,$$

где  $v$  – скорость упорядоченного движения свободных электронов.

Второе уравнение гидродинамики для тока свободных электронов было модифицировано введением анизотропной массы свободных носителей, описываемых тензором эффективных масс  $\hat{M}_f$ . Система решалась тем же способом, что и в работе [7]. Уравнение для поляризации интегрировалось неявным методом. Переписывая (4) в виде обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка для вектора  $(\mathbf{P}, \mathbf{Q})$ , где  $\mathbf{Q} = \dot{\mathbf{P}}$ , и используя значения данных величин в разные моменты времени:  $\mathbf{p}_i = \mathbf{P}(t_i)$ ,  $\mathbf{q}_i = \mathbf{Q}(t_i - dt/2)$ , получаем следующую алгебраическую систему:

$$\mathbf{q}_{i+1} - \mathbf{q}_i + \frac{v_b}{2}(\mathbf{q}_{i+1} + \mathbf{q}_i)dt = (-\omega_b^2 \mathbf{p}_i + \beta \mathbf{E}_i)dt,$$

$$\mathbf{p}_{i+1} - \mathbf{p}_i = \mathbf{q}_{i+1}dt.$$

Видно, что величины  $\mathbf{p}_{i+1}$  и  $\mathbf{q}_{i+1}$  могут быть явно вычислены по значениям  $\mathbf{p}_i$  и  $\mathbf{q}_i$ . Расчет величины  $\mathbf{q}_{i+1}$  проводился до расчета электрического поля  $\mathbf{E}_{i+1} = \mathbf{E}(t_i + dt)$ .

1. Hilton D.J., Averitt R.D., Meserole C.A., et al. *Opt. Lett.*, **29**, 1805 (2004).
2. Kadlec F., Kuzel P., Coutaz J.-L. *Opt. Lett.*, **29**, 2674 (2004).
3. Kadlec F., Kuzel P., Coutaz J.-L. *Opt. Lett.*, **30**, 1402 (2005).
4. Suvorov E.V., Akhmedzhanov R.A., Fadeev D.A., et al. *Opt. Lett.*, **37**, 2520 (2012).
5. Урюпин С.А., Фролов А.А. *ЖЭТФ*, **141**, 1006 (2012).
6. Урюпин С.А., Фролов А.А. *Квантовая электроника*, **44** (9), 866 (2014).
7. Миронов В.А., Оладышкин И.В., Суворов Е.В., Фадеев Д.А. *ЖЭТФ*, **146** (2), 211 (2014).
8. Ахмеджанов Р.А., Иляков И.Е., Миронов В.А., Оладышкин И.В., Суворов Е.В., Фадеев Д.А., Шишкин Б.В. *Изв. вузов. Сер. Радиофизика*, **57** (11), 902 (2014).
9. Oladyshkin I.V., Fadeev D.A., Mironov V.A. *J. Opt.*, **17**, 075502 (2015).
10. *Поверхностные поляритоны. Сборник статей.* Под ред. В.М.Аграновича, Д.Д.Миллса (М.: Наука, 1985).
11. Мамонова М.А., Прудников В.В., Прудникова И.А. *Физика поверхности. Теоретические модели и экспериментальные методы* (М.: Физматлит, 2011).
12. Оладышкин И.В. *Письма в ЖЭТФ*, **103**, 495 (2016).
13. Фальковский Л.А. *УФН*, **94**, 3 (1968).
14. Эдельман В.С. *УФН*, **123**, 257 (1977).
15. Madelung O. *Semiconductors: Data Handbook* (New York: Springer-Verlag, 2003).
16. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. *Электродинамика сплошных сред* (М.: Наука, 1982).